

Содержание

● Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Гурбанов Г.Р., Адыгезалова М.Б.

Характер взаимодействия в системе $\text{SnSb}_2\text{Te}_4\text{—SnBi}_2\text{Te}_4$ и термоэлектрические свойства твердых растворов $(\text{SnSb}_2\text{Te}_4)_{1-x}(\text{SnBi}_2\text{Te}_4)_x$ 483

● Электронные свойства полупроводников

Бахадирханов М.К., Исамов С.Б., Зикриллаев Н.Ф., Турсунов М.О.

Аномальные фотоэлектрические явления в кремнии с нанокластерами атомов марганца 489

Рабданов М.Р., Степуренко А.А., Гумметов А.Э., Исмаилов А.М.

Температурная зависимость проводимости нитевидных кристаллов теллура 493

Nemov S., Kostyuk O., Dzundza B., Chernyak L., Dashevsky Z.

High Perfection Bulk and Film Thermoelectrics Based on PbTe Doped by In 499

Abraham R.J.S., Shuman V.B., Portsel L.M., Lodygin A.N., Astrov Yu.A., Abrosimov N.V., Pavlov S.G., Hübers H.-W., Simmons S., Thewalt M.L.W.

Thermal Activation of Valley-Orbit States of Neutral Magnesium in Silicon 500

● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Abdel Moez A., Salem M.A., Elmeleegi A., Elmandouh Z.S.

Investigation of Structure, First Order Optical Susceptibility, Non-linear Optical, Electrical Susceptibility Results and IV Characterizations of Graphene Multilayer 501

● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Семакова А.А., Баженов Н.Л., Мынбаев К.Д., Черняев А.В., Кижанов С.С., Стоянов Н.Д.

Исследование вольт-амперных характеристик светодиодных гетероструктур на основе InAsSb в диапазоне температур 4.2–300 K 502

● Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Fan Zhang, Черкова С.Г., Володин В.А.

Формирование нанокристаллов германия в пленках $\text{GeO}[\text{SiO}_2]$ и $\text{GeO}[\text{SiO}]$ 507

Нагалюк С.С., Мохов Е.Н., Казарова О.П., Бер Б.Я., Анисимов А.А., Бреев И.Д.

Возникновение зеленой окраски в кристаллах AlN, выращенных на затравках SiC 513

● Углеродные системы

Морозов М.Ю., Моисеенко И.М., Коротченков А.В., Попов В.В.

Замедление терагерцовых плазменных волн в конической структуре с графеном, накачиваемым с помощью оптических плазменных волн 518

● Физика полупроводниковых приборов

Тандоев А.Г., Мнацаканов Т.Т., Юрков С.Н.

Вольт-амперная характеристика мощных диодных структур с резкой асимметрией инжектирующей способности эмиттеров 524

● Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Brella M., Taabouche A., Gharbi B., Gheriani R., Bouachiba Y., Bouabellou A., Serrar H., Touil S., Laggoune K., Boudissa M.

Comparison of Thin Films of Titanium Dioxide Deposited by Sputtering and Sol–Gel Methods for Waveguiding Applications 533

Pradhan D., Kar J.P.

Microstructural and Electronic Properties of Rapid Thermally Grown MoS_2 /Silicon Hetero-Junctions with Various Process Parameters 534

Учредители:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Российская академия наук
Ленинский пр., 14, Москва, 199000
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
Российской академии наук
Политехническая ул., 26, Санкт-Петербург, 194021
Телефон: (812)297-2245. Факс: (812)297-1017
post@mail.ioffe.ru <http://www.ioffe.ru>

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации
Регистрационный номер ПИ № ФС77-71300 от 17 октября 2017 г.

Издатель: ФТИ им. А. Ф. Иоффе
194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Адрес редакции: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
semicond@mail.ioffe.ru
<http://www.ioffe.ru/journals/ftp/>

Зав. редакцией *С. Б. Короткова*

Компьютерный набор и изготовление оригинал-макета
ФТИ им. А. Ф. Иоффе
194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Подписано к печати 31.05.2021. Дата выхода в свет 30.06.2021.
Формат 60×90 1/8.
Усл. печ. л. 6.8. Уч.-изд. л. 6.4.
Тираж 52 экз.
Тип. зак. № 0000. Цена свободная.

Отпечатано с предоставленных готовых файлов
в полиграфическом центре ФГУП Издательство „Известия“
127254, Москва, ул. Добролюбова, 6
телефон: (495)650-3880, <http://izv-udprf.ru>